

Capitolo 1

Estrazione dei paramentri statici

1.1 Tensione di soglia

La tensione di soglia V_{th} di un transistor MOS è definita come quella tensione tra gate e bulk per la quale la popolazione di minoritari all'interfaccia è uguale alla popolazione di maggioritari nel bulk. Questa definizione non può essere usata direttamente per il calcolo della tensione di soglia dei dispositivi, ma si deve passare attraverso l'analisi delle caratteristiche corrente-tensione dei dispositivi.

Per l'estrazione del parametro V_{th} esistono numerosi metodi, ognuno con punti di forza e punti di debolezza diversi. La scelta di quale metodo utilizzare non è banale e per farla occorre analizzare le caratteristiche di ciascun metodo e confrontare i risultati che offrono. per questo studio sono stati presi in considerazione:

- *Transconductance Change Method (TCM)*;
- *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method (SDLM)*;
- *Extrapolation in the Linear Region method (ELR)*.

1.1.1 Transconductance Change Method

Il *Transconductance Change Method*, *TCM*, defiscisce la tensione di soglia come la tensione di gate V_{GS} corrispondente al picco massimo della derivata della transconduttanza g_m rispetto alla tensione di gate ($\frac{dg_m}{dV_{GS}}$) ed è valido

per bassi valori della tensione V_{DS} .

Questa definizione si basa sul fatto che, quando il dispositivo passa dalla regione di debole inversione alla regione di forte inversione, la dipendenza della corrente di drain rispetto a V_{GS} passa dall'essere esponenziale all'essere quasi costante. La transconduttanza è definita come la derivata prima della corrente I_D rispetto alla tensione V_{GS} , dunque la derivata della g_m corrisponde alla derivata seconda di I_D . Per questo motivo, il massimo di $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ coincide con la tensione alla quale il grafico della corrente passa dalla forma esponenziale a quella quasi costante, ovvero la tensione $V_{GS} + V_{DS}$. Se V_{DS} è piccola, la tensione per la quale la g_m è massima è molto simile a V_{th} .

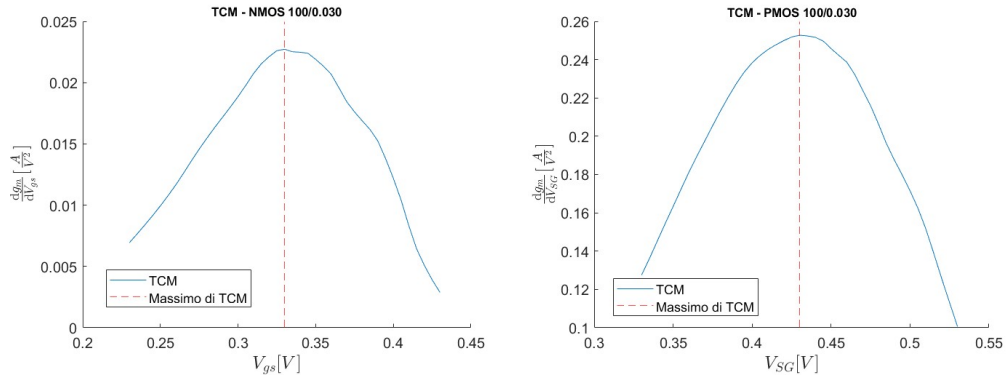


Figura 1.1: Esempio di *TCM* usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a $V_{DS} = 150mV$

Il *TCM*, poiché si basa sul massimo di una funzione, è molto sensibile ai picchi dovuti ad errori di misura e perciò non è molto affidabile: è quindi necessario rendere la funzione studiata meno dipendente dai campionamenti fuori scala. Inoltre, la risoluzione del dispositivo di misura utilizzato è di $5mV$, il che rende i valori ottenuti della V_{th} molto approssimativi. Per far fronte a questi due problemi, si è scelto di non tenere conto del massimo direttamente ottenuto dallo studio di $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ ottenuto dai valori delle misure, ma di interpolare prima i punti del grafico con una funzione polinomiale e, solo a questo punto, di prendere in considerazione il picco di massimo.

Lo studio del fit polinomiale risolve il problema della bassa risoluzione di misura e il problema della presenza di valori fuori scala, ma presenta una

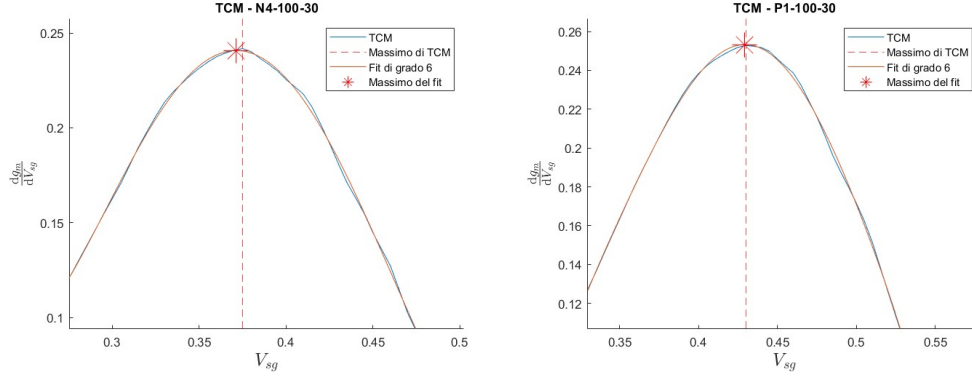


Figura 1.2: Esempio di *TCM* con fit polinomiale usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a $V_{DS} = 150mV$

potenziale nuovo problema: il valore della V_{th} calcolata potrebbe variare significativamente al variare del grado della funzione polinomiale interpolante. Prendendo come esempio i dispositivi PMOS, si è studiato quanto cambia il valore della tensione di soglia al variare del grado del fit polinomiale, prendendo in considerazione i gradi di valore 2, 4, 6 e 8.

Osservando i valori nella tabella 1.1, si può notare che la tensione di soglia ottenuta non varia molto nel caso dei fit fatti con polinomiali di grado 4, 6 e 8: è raro che la differenza tra questi valori superi $1mV$. Non si può dire la stessa cosa per le V_{th} calcolate con fit di grado 2: in questo caso la funzione interpolante ha un grado troppo basso per seguire in modo coerente la curva $\frac{dg_m}{dV_{GS}}$ e quindi il massimo risulta essere sia molto diverso da quelli calcolati con fit di grado maggiore, sia da quello di ottenuto senza fit. Dunque di sicuro usare un fit di grado 2 porta a risultati scorretti, mentre usare un fit di grado superiore dovrebbe portare a risultati sicuramente accettabili. Per il confronto con altri metodi per l'estrazione della V_{th} si terrà quindi conto del TCM con fit polinomiale di grado 6.

1.1.2 Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method

Il secondo metodo analizzato è il *Second Difference of the Logarithm of the drain current Minimum method*, *SDLM*. Questo metodo definisce la V_{th} come

Tabella 1.1: Confronto dei valori di V_{th} dei dispositivi PMOS ottenuti con TCM con fit polinomiale di diversi gradi

Dispositivo	V_{th} con fit di grado 2 [mV]	V_{th} con fit di grado 4 [mV]	V_{th} con fit di grado 6 [mV]	V_{th} con fit di grado 8 [mV]
100 - 30	426.9	429.4	429.4	430.8
100 - 60	467.6	469.5	469.3	468.9
200 - 30	495.6	495.6	495.3	495.5
200 - 60	397.8	399.7	399.3	399.8
200 - 180	452.2	454.1	453.5	453.5
600 - 30	478.5	480.8	480.6	480.0
600 - 60	383.0	387.4	385.9	386.2
600 - 180	431.1	434.3	434.7	435.6

la tensione V_{GS} per la quale si ha il picco minimo della derivata seconda del logaritmo naturale di I_D ripetuto alla tensione di gate ($\frac{d^2 \ln I_D}{dV_{GS}^2}$) e vale solo per alti valori di V_{DS} .

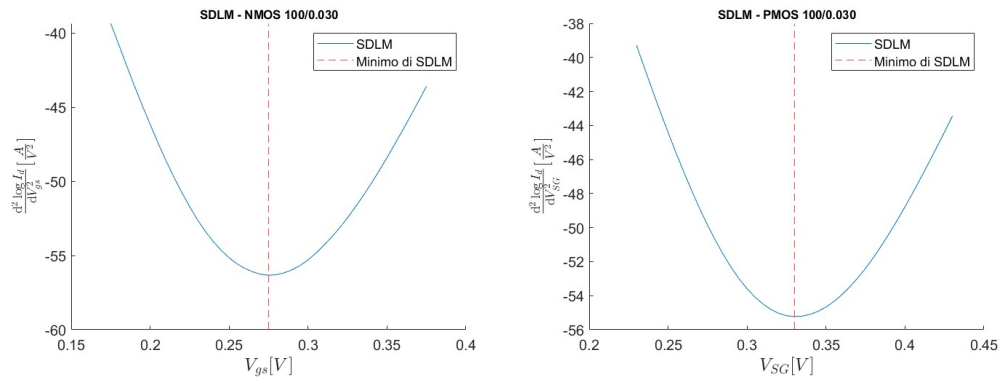


Figura 1.3: Esempio di $SDLM$ usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a $V_{DS} = 900mV$

Tabella 1.2: V_{th} dei dispositivi PMOS estratte con *TCM*

Dispositivo	$V_{th}[mV]$ pre-irraggiamento	$V_{th}[mV]$ 5Mrad	$V_{th}[mV]$ 50Mrad
100 - 30	429.4	430.7	432.2
100 - 60	469.3	469.6	471.4
200 - 30	495.3	497.1	503.9
200 - 60	399.3	401.0	403.1
200 - 180	453.5	455.2	456.2
600 - 30	480.6	481.5	483.7
600 - 60	385.9	386.6	388.8
600 - 180	434.7	435.4	438.5

Dispositivo	$V_{th}[mV]$ 100Mrad	$V_{th}[mV]$ 200Mrad	$V_{th}[mV]$ 600Mrad	$V_{th}[mV]$ 1Grad
100 - 30	434.4	439.0	452.6	459.4
100 - 60	472.7	479.7	491.8	500.8
200 - 30	506.5	511.3	524.1	535.3
200 - 60	404.8	410.2	422.3	429.8
200 - 180	458.6	463.8	476.9	485.8
600 - 30	486.0	492.0	507.2	519.6
600 - 60	391.0	394.5	405.5	412.3
600 - 180	438.9	445.6	458.4	467.8

I due metodi appena esposti, però, sono molto sensibili ai picchi dovuti ad errori di misura e perciò sono difficilmente utilizzabili se prima non si rendono i grafici più puliti. Inoltre, la risoluzione del dispositivo di misura utilizzato è di $5mV$, il che rende i valori ottenuti della V_{th} molto approssimativi. Per far fronte a questi due problemi, si è scelto di non tenere conto del minimo e del massimo direttamente ottenuti dalle derivate delle misure fatte, ma di interpolare prima i punti dei grafici ottenuti con una funzione polinomiale e solo a questo punto di prendere in considerazione i picchi di minimo o di massimo.

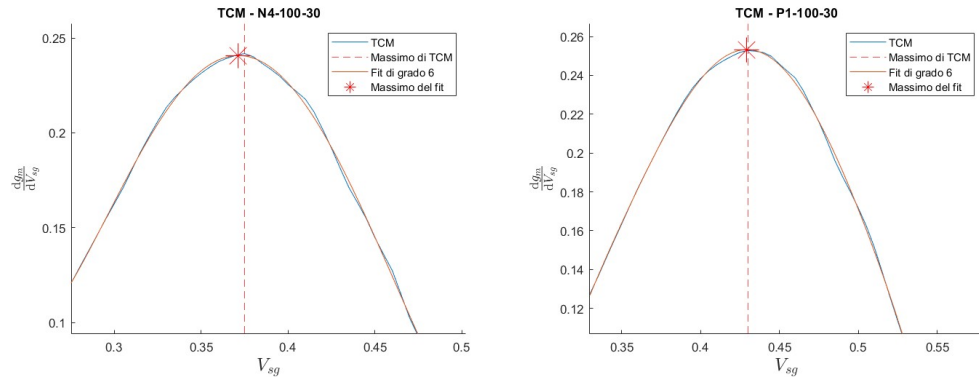


Figura 1.4: Esempio di *TCM* con fit polinomiale usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a $V_{DS} = 150mV$

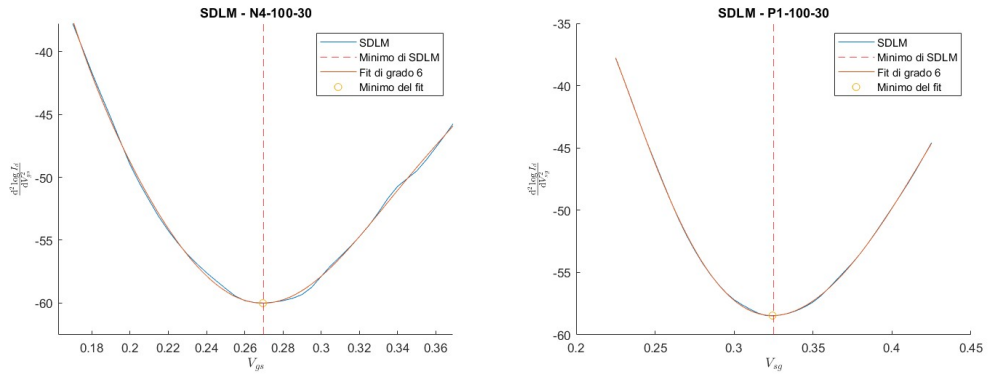


Figura 1.5: Esempio di *SDLM* con fit polinomiale usato su un dispositivo NMOS e un dispositivo PMOS di dimensioni 100-30 a $V_{DS} = 900mV$

Per valutare l'accuratezza di questi due metodi si sono quindi calcolate le V_{th} relative ai dispositivi di un PMOS, ottenendo i risultati seguenti:

Tabella 1.3: characteristic normalized drain current I_Z^* [μA]

Dispositivo	V_{th} calcolata con TCM [mV] ($V_{SD} = 150mV$)	V_{th} calcolata con SDL M [mV] ($V_{SD} = 900mV$)
100 - 30	480.6	441.4
100 - 60	469.3	411.6
200 - 30	399.3	296.5
200 - 60	453.5	404.9
200 - 180	495.3	449.3
600 - 30	385.9	289.7
600 - 60	434.7	391.8
600 - 180	480.6	441.4

In generale i risultati sono abbastanza simili tra le due colonne, per cui si potrebbe prendere in considerazione uno di questi due metodi per estrarre le tensioni di soglia e studiarne la degradazione.

È stato però notato un problema non indifferente: il valore della V_{th} estratta dipende dal grado della funzione polinomiale che interpola i punti delle derivate usate per SDL M e TCM. La differenza dei valori estratti al variare del grado non è molto alta, si parla di pochi millivolt, perciò non influenza considerevolmente il valore della singola estrazione. Questa dipendenza, però, è problematica nel momento in cui si vuole studiare con precisione la degradazione della prestazioni di un dispositivo all'aumentare dell'irraggiamento subito, in quanto piccoli spostamenti del valore di V_{th} dovuti alla scelta arbitraria del grado della polinomiale può far variare eccessivamente le differenze della misure tra un irraggiamento e l'altro, elemento inaccettabile se si considera che già le misure sono influenzate da errori casuali in fase di misura.

Come esempio si riporta il caso della *SDL M* di un PMOS di dimensioni 600-30 con funzione polinomiale interpolatrice di grado 2, 4, 6 e 8. I valori della V_{th} ottenuti sono:

Grado della polinomiale	$V_{th}[mV]$
2	296.0
4	291.4
6	299.7
8	298.1

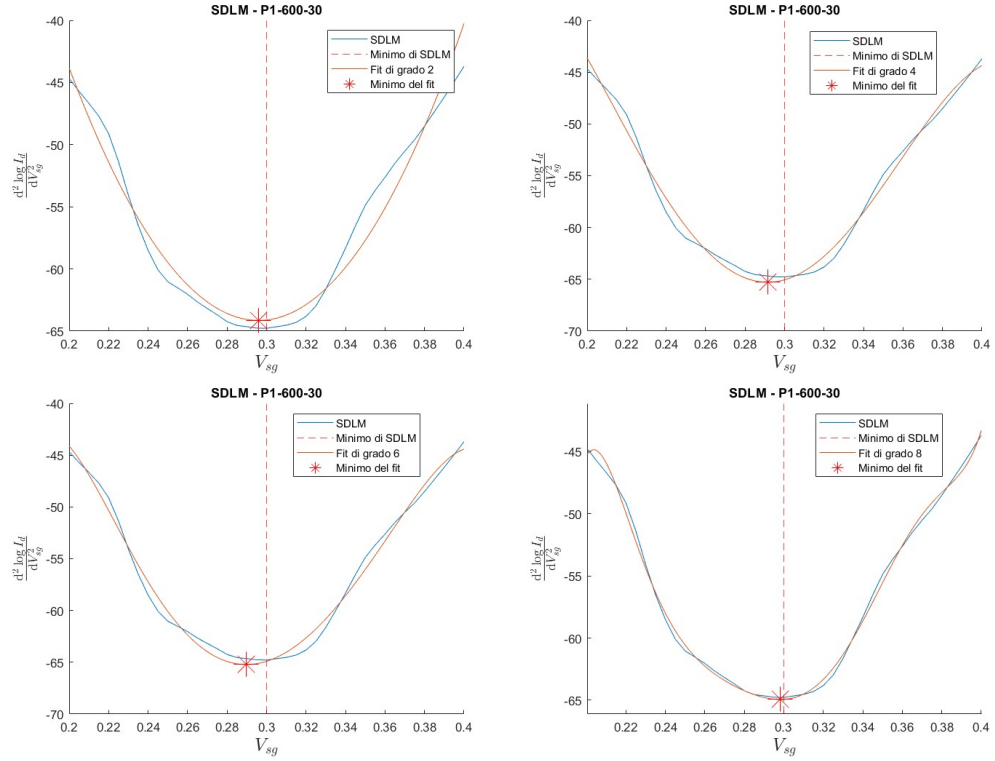


Figura 1.6: Emempi di grafici di *SDLM* su un PMOS di dimensioni 600-30 con fit polinomiale di diversi gradi

Per questo motivo si è valutato di utilizzare un terzo metodo: l'*Extrapolation in the Linear Region method, ELR*, con il quale si ottiene la misura della V_{th} attraverso l'analisi della caratteristica $I_D - V_{GS}$. Tale grafico presenta un punto di flesso attorno al quale il grafico è linearizzabile. Tracciando il fit lineare nell'introno del punto di flesso si ottiene una retta che interseca l'asse delle ascisse, ovvero quello di V_{GS} , in un punto il cui valore corrisponde a quello della V_{th} .

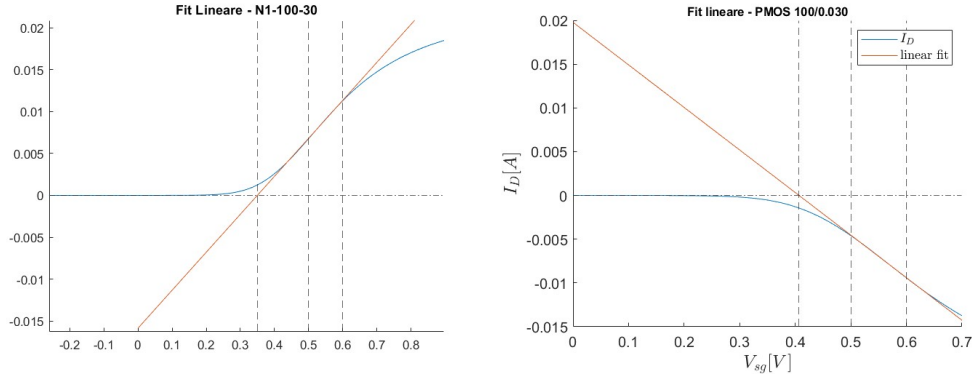


Figura 1.7: Fit lineare della caratteristica I_D - V_{GS} a $V_{DS} = 150mV$ di un NMOS e di un PMOS di dimensioni 100-30 nell'intorno $[0, 4V; 0, 6V]$ di V_{GS}

Di per sè, questo metodo è meno preciso di quelli esposti precedentemente, però è più affidabile nella misura delle differenze di V_{th} man mano che i dispositivi vengono irraggiati. problema con le resistenze parassite